## 深紫外レーザの Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>N ガイド層における不純物濃度と光損失の関係 Relationship between impurity concentration and optical loss in Al<sub>0.5</sub>Ga<sub>0.5</sub>N guide layer of deep ultraviolet laser

<sup>•(B4)</sup>田中隼也<sup>1</sup>、川瀬雄太<sup>1</sup>、佐藤恒輔<sup>1,3</sup>、岩谷素顕<sup>1</sup>、竹内哲也<sup>1</sup>、上山智<sup>1</sup>、赤﨑勇<sup>1,2</sup> <sup>1</sup>名城大・理工、<sup>2</sup>名古屋大・赤﨑記念研究センター、<sup>3</sup>旭化成

°(B4)S. Tanaka<sup>1</sup>, Y. Kawase<sup>1</sup>, K. Sato<sup>1,3</sup>, M. Iwaya<sup>1</sup>, T. Takeuchi<sup>1</sup>, S. Kamiyama<sup>1</sup>, and I. Akasaki<sup>1,2</sup> <sup>1</sup>Fac. Sci & Tec., Meijo Univ., <sup>2</sup>Akasaki Research Center, Nagoya Univ, <sup>3</sup>Asahi-Kasei.

## Email: 150443032@ccalumni.meijo-u.ac.jp

**背景** 深紫外レーザは医療・バイオ分野など様々な領域への応用が可能であり実現が期待されて いる。その実現に向けて研究が行われているが、電流注入型レーザの実現に向けて、ドナー・ア クセプタ不純物濃度を制御することは、キャリア注入および光導波路形成において非常に重要な 課題である。本研究は光ガイド層の不純物濃度に注目した。同層の不純物添加はキャリアの注入 効率向上に期待ができる一方で光学ロスにつながるトレードオフがあるため、その最適化は高性 能デバイスを実現する上で不可欠であると考えられる。本検討ではガイド層における不純物濃度 と光損失の関係について詳細に調査したのでその結果に関して報告する。

<u>実験</u> c面サファイア基板上AINテンプレートを用い、MOVPE法を用いてその上に図1に示すよう な発振波長290-300nmの光励起レーザを作製した。本研究では上部AlGaNガイド層に1.5×10<sup>19</sup> [cm<sup>-3</sup>]のMgを添加(Cp<sub>2</sub>Mgの供給量9.9 [nmol/min])した試料を基準としCp<sub>2</sub>Mgの供給量を変化させて作 製した試料と、下部AlGaNガイド層に8.7×10<sup>18</sup> [cm<sup>-3</sup>]のSiを添加した試料(SiH4の供給量1.9 [nmol/min])を基準として、SiH4の供給量を変化させて作製した試料を準備しそれを評価した。

<u>結果</u> 図2に各試料の光励起による発光強度の励起パワー密度依存性を示す。ガイド層に不純物を 添加していない試料と比較すると、不純物SiやMgをそれぞれ添加した試料は、不純物原料の供給 量が高くなるにつれて共に高い閾値で発振した。以上から、不純物による光吸収の影響が閾値に 関係することが確認できた。その他のパラメータの解析結果は当日報告する。

【謝辞】本研究の一部は文部科学省・私立大学研究ブランディング事業、科研費・基盤 A(15H02019)、 科研費・基盤 A(17H01055)、科研費新学術(16H06416)、および JST CREST(16815710)の援助に より実施された。





Fig.1. Sample structure of AlGaN deep ultraviolet optically pumped laser

